



株式会社三菱ケミカルリサーチ
東京都新宿区左門町 16 番地 1
〒160-0017

情報電子・IT 通信調査部 仁田山晃寛さん Test of Time Award 受賞について

仁田山さんは、米国電気電子学会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers : IEEE) が主催する半導体の最高峰の国際学会「VLSI Symposia on VLSI Technology and Circuits」(略称 VLSI シンポジウム) で「Test of Time Award」を受賞いたしました。

この賞は歴史にその重要性を確立した論文を表彰するもので、VLSI シンポジウムにおいて永続的な影響を与えたものに対し毎年 1 論文に与えられます。

この論文は 2007 年の VLSI シンポジウムで論文審査の最高得点を獲得しました。世界のデータ量の指数関数的爆発に対する一つの解決策として発明した 3D NAND Flash の最初の発表論文であり、基本概念と実証実験を披露したものです。従来の NAND Flash の微細化限界が叫ばれている中、大胆な 3 次元化技術であったため、発表当初は世界の半導体メーカーに衝撃が走りました。その後は多くの半導体メーカーがこの技術を引用や参考にし、同様の技術開発に邁進しました。現在、3D NAND Flash の世界市場の売り上げ規模は 10 兆円に達しています。携帯電話に多くの動画を保存できるようになったのもこの技術のお蔭です。

仁田山さんにお聞きしたところ、この受賞に関して特筆すべきことはこの論文の作成にあたり、入社直後の若手社員にチューターをつけ、1 年目に一流の国際学会に論文投稿し 2 年目に発表させる育成体制をとってきたことです。若手に夢と勇気を与えれば、柔軟な発想でイノベーションを起こし結果として、会社のプレゼンスが高まることが期待されます。